# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number 06186544 A

(43) Date of publication of application: 08.07.94

(51) Int. CI

G02F 1/1333 G02F 1/1335 G02F 1/136

(21) Application number 04341837

(22) Date of filing 22.12.92

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor

IDO MASUMI TAKUBO YONEJI

(54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

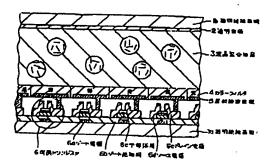
voltage is impressed thereto.

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the reflection type liquid crystal display device which is formed by using a polymer dispersion type liquid crystal and can make bright white display with low electric power consumption.

CONSTITUTION This reflection type liquid crystal display device is constituted by providing thin-film transistors 6 formed on a first transparent insulating substrate 1a, pixel electrodes 5 of a reflection type electrically connected via insulating layers to the drain electrodes 6e thereof and color filters 4 formed in the upper parts of these pixel electrodes 5 and sealing a light scatterable liquid crystal mixture layer 3 consisting of a liquid crystal compsn. and a nonliquid crystalline high-polymer compd. between this first transparent insulating substrate 1a and a second transparent insulating substrate 1b formed with transparent electrodes 2. The liquid crystal mixture layer 3 makes white display by scattering incident light in the state of not impressing a voltage thereto. The light is transmitted through the above-mentioned layer and is reflected by the pixel electrodes 5 when the

COPYRIGHT (C)1994, JPO& Japio



oles, i e

#### (19)日本国特計庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平6-186544

(43)公開日 平成6年(1994)7月8日

1/1333 9225-2K 1/1935 5 0 5 7408-2K 1/136 5 0 9018-2K	(51)IntCl. <sup>6</sup> G 0 2 F			7408-2K	FI			技術表示的	——
---	------------------------------------	--	--	---------	----	--	--	-------	----

#### 審査請求 未請求 請求項の数 2(全 3 頁)

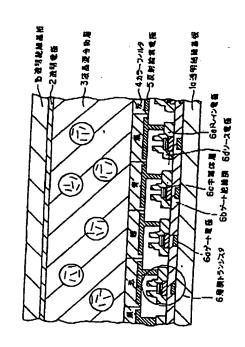
(21)出顧番号	特斯平4—341837	(71)出版人 000005821
(22)出願日	平成 4年(1992)12月22日	松下電器底業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72)売明者 井▲土▼ 眞 遼 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 底業株式会社内 (72)発明者 田 飛 米 治
		大阪府門頁市大字門頁1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 蔵合 正博

(54)【発叨の名称】 反射型液晶表示装置

#### (57)【要約】

【目的】 木発明は、ポリマー分散型液晶を用いた反射型液晶表示装置に関するもので、低消費電力で明るい白色表示のできるフルカラーの反射型液晶表示装置を提供することを目的とする。

【構成】 第1の透明絶縁基板1 a 上に形成された薄膜トランジスタ6と、そのドレイン電極6 e に絶縁層を介して電気的に接続された反射型の絵楽電極5と、絵素電極5の上部に形成されたカラーフィルタ4とを備え、この第1の透明絶縁基板1 a と透明電極2を形成した第2の透明絶縁基板1 b との間に、液晶組成物と非液晶性高分子化合物とからなる光散乱性の液晶混合物層3を封入した構成とする。液晶混合物層3は、電圧を印加しない状態では入射した光を散乱して白色表示となり、電圧を印加すると光を透過して反射絵素電極5で反射される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成された狩猟トランジスタ と、前記海膜トランジスタのドレイン電極に絶縁倍を介 して電気的に接続された反射型の絵素電極と、前配絵楽 **電極の上部に形成されたカラーフィルタとを有する第**1 の透明絶録基板と、透明電極を形成された第2の透明絶 板との間に封入された液晶組成物と非液晶性高分子化合 物とからなる液晶混合物層とを備えた反射型液晶表示装 窊

【請求項2】カラーフィルタは、赤、緑、青、黒の4色 で構成されていることを特徴とする請求項1記載の反射 型液品表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、低消費電力で明るい表 示が可能な反射型液晶表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】被品表示装置(以下してDと略記)は、 薄膜、軽量、低消費電力といった特徴を有しており、デ 20 ィスプレイ分野において、技術的にも市場的にも日ざま しい成長を続けるとともに、確固たる地位を築いてい

【0003】 LCDの用途として、電卓、腕時計などの セグメント表示や、テレビ、コンピュータなどのマトリ クス表示があるが、その中でも特に開発、商品化が活発 に行なわれているのは、パソコン、ワードプロセッサ等 の〇A用ディスプレイである。現在、このような〇A用 ディスプレイには、スーパー・ツイステッド・ネマティ と、蔕収トランジスタ(TFT)などのスイッチング素 子を各絵素ごとに配置した基板およびツイステッド・ネ マティック(TN)モードの液晶を組み合わせた、いわ ゆるアクティブマトリクス型しCDが用いられている。

【0001】アクティブマトリクス型とは、従来の単純 マトリクス型に対比して言われている液晶の駆動方式を **滋味しているもので、マトリクス状に配置された絵素電** 極にそれぞれスイッチング素子を設け、それらのスイッ チング素子を介して、各絵素電極に液晶の光学特性を制 御する芭気信号を独立に供給する方式である。このアク 40 ティブマトリクス型の方式は、大容量の表示を行なって も髙画質表示が得られることから、ディスプレイの本命 として開発、商品化が盛んである。

【0005】ディスプレイの構成としては、透過型と反 射型のものがある。反射型のディスプレイは、透過型の ような光源(バックライト)が不要であることから、低 消費電力が実現でき、ノートバソコン,ラップトップコ ンピュータの用途としては極めて適した構成といえる。 【〇〇〇6】しかし、現在の反射型方式は偏光板を用い るために、周辺光量が少ない場合に非常に暗くなるこ

と、また反射面として金属を用いているために、白色表 示およびカラー化が困難であるといった欠点を有してい る。

. 2

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、 かかる点に 鑑みてなされたもので、表示品位の高いカラーの反射型 液晶表示装置を提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の反射型液晶表示 10 装置は、第1の透明絶縁基板上に薄膜トランジスタを形 成し、この蒋膜トランジスタのドレイン電極に絶縁層を 介して電気的に接続された反射型の絵素電極と、この絵 素面極の上部に形成されたカラーフィルタとを備え、第 1 の透明絶縁茘板と透明電極を形成した第2の透明絶縁 基板との間に、液晶組成物と非液晶性高分子化合物とか らなる液晶混合物層を封入したものである。

[0009]

【作用】本発明は、上記構成により、液晶混合物層に電 圧を印加しない状態では、入射した光は散乱して白色表 示となるので白色表示が可能となり、また液晶混合物層 に電圧を印加すると、人射した光が透過して絵素電極で 反射されカラーフィルタを通って出射するので、明るい フルカラー表示が可能となる。

[0010]

【実施例】以下、本発明に関わる実施例の詳細について 述べる。図1は本発明の一実施例を示す反射型液晶表示 装置の構成断[[[図である。図1において、1 a, 1 b は ガラスなどの透明絶縁基板、2は透明電極(IT〇)、 3 は液量組成物と非液晶性高分子化合物からなる液晶混 ック(STN)モードを用いた単純マトリクス型しCD 30 合物層で、本実施例ではポリマー分散型液晶(PDーL C) を用いた。 4 はカラーフィルタであり、赤,緑, 青,黒色の連続からなる。5は反射絵素电極でAlを用 いた。 6は蔕膜トランジスタである。 蔕膜トランジスタ 6は、ゲート電極6aとしてCr金属、ゲート絶縁膜6 bとしてはSiNx、半導体層6cとしてa-Si、ソ ース、ドレイン電極6d、6eとしてA1を用いた逆ス タガ構造の薄膜トランジスタである。 反射絵素電極 5 は、薄膜トランジスタ、6の上部に構成されており、ドレ イン電板6eとはSiNxの絶縁膜を介してコンタクト ホールを設けて電気的に接続されている。

【0011】次に本実施例の動作について説明する。被 晶混合物層3は、液晶組成物が高分子化合物中に分散し て存在しているものであって、電圧無印加の状態では、 人射した光は、液晶中および液晶/高分子化合物界面で 散乱され、 白色表示となる。

【0012】一方、狩膜トランジスタ6を介して反射絵 素電極5に電圧を供給し、液晶混合物層3に電圧を印加 した場合は、液晶分子は電界方向に配向し、液晶組成物 と高分子化合物の屈折率がほぼ等しくなるため、入射光 は液晶混合物層3中をそのまま直進し、下側に配したカ

15.15

ラーフィルタ4が見えるようになる。 カラーフィルタ4 は、赤、緑、青、黒色で構成されているので、カラーお よび自然表示が失現できる。

【0013】上記した構成で実際にパネルを評価したと ころ、バックライトを用いた透過型の液晶表示装置とほ ぼ同等の色再現性を得ることができ、コントラストも2 0:1以上を確認できた。

#### [0014]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、基板上 に形成された冷膜トランジスタと、冷膜トランジスタの 10 4 カラーフィルタ ドレイン電極に絶縁層を介して電気的に接続された反射 型の絵素電極と、絵素電極の上部に形成されたカラーフ ィルタとを有する第1の透明絶縁基板と、透明電極を形 成された第2の透明絶縁基板と、第1の透明絶縁基板と 第2の透明絶録某板との間に封入された液晶組成物と非 液晶性再分子化合物とからなる液晶混合物層とを備えて いるので、明るい白色表示のできるフルカラーの反射型 液晶表示装置を提供することができる。 これにより、低

消**交電力**の〇A用ディスプレイの実現が可能となり、そ の効果は極めて多人である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す反射型液晶表示装置の 構成断面図である。

#### 【符号の説明】

- la, lb 透明絶縁基板
- 2 透明電板
- 3 液晶混合物后
- 5 反射絵素電極
- 6 薄膜トランジスタ
- 6a ゲート電板
- 6 b ゲート絶縁膜
- 6 c 半導体層
- 6 d ソース電極
- 6 e ドレイン電極

[図1]

